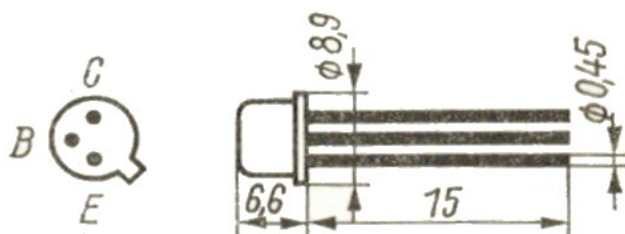


RFT BSY34

Silizium- npn- Planar- Epitaxie- Transistor im TO-39 Gehäuse
für den Einsatz in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber



Wärmewiderstand	R_{thja}	\leq	220K/W
	R_{thjc}	\leq	60K/W

Grenzwerte

U_{CBO}	=	60V	I_B	=	200mA
U_{CES}	=	60V	ϑ_j	=	200°C
U_{CEO}	=	40V	ϑ_s	=	-65°C ... +200°C
U_{EBO}	=	5V	P_{tot}	=	2,6W (bei $\vartheta_\alpha = 45^\circ\text{C}$)
I_C	=	600mA			

Statische Kennwerte

I_{CBO}	(bei $U_{CBO} = 50V$)	\leq	70nA
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_{CEO} = 10mA$)	\geq	40V
$U_{(BR)CES}$	(bei $I_{CES} = 10\mu A$)	\geq	60V
U_{CEsat}	(bei $I_C = 500mA$, $I_B = 50mA$)	\leq	1V
U_{BEsat}	(bei $I_C = 500mA$, $I_B = 50mA$)	\leq	1,5V
h_{21E}	(bei $U_{CE} = 1V$, $I_C = 100mA$)	\geq	25
h_{21E}	(bei $U_{CE} = 1V$, $I_C = 500mA$)	\geq	10

Dynamische Kennwerte

f_T	(bei $U_{CE} = 10V$, $I_C = 30mA$, $f=100MHz$)	\geq	250MHz
t_{on}	(bei $I_C = 500mA$, $I_{B1} = 50mA$)	\leq	50nS
t_{off}	(bei $I_{B2} = 25mA$, $R_L = 80\Omega$)	\leq	95nS

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985